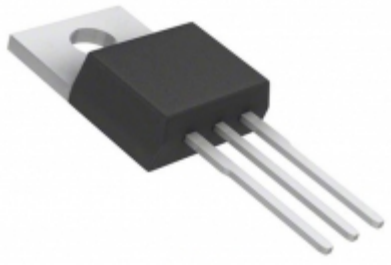



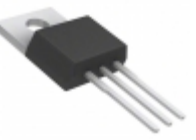



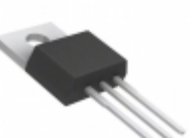
	<h2 style="color: red;">FDP26N40</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP26N40</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 26A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP26N40.pdf 2.FDP26N40.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23218 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP26N40
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 26A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23218 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	265W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	26A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3185pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP26N40 ist neu im Original, Suche FDP26N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP26N40 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP26N40: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP2710-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A TO-220</p>	 <p>FDP2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A TO-220</p>	 <p>FDP2710 FDK America MOSFET N-CH 250V 50A TO-220</p>	 <p>FDP26N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 26A TO-220</p>
 <p>FDP2670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220AB</p>	 <p>FDP2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220AB</p>	 <p>FDP2614 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A TO-220</p>	 <p>FDP2614 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP16N50	↔ FDP16N50-0704	⇒ FDP18N20F	D FDP18N20F	⇒ FDP18N20V2
⊣ FDP18N50	⊗ FDP18N50	D FDP19N40	⇒ FDP19N40	⇒ FDP20AN06A0
⊗ FDP20AN06A0	⊣ FDP20AN06AO	⊗ FDP20N50	↔ FDP20N50	⇒ FDP20N50F
D FDP20N50F	⊗ FDP20N60	⊣ FDP22N50N	⊗ FDP22N50N	⇒ FDP24AN06LA0
⇒ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LAO	⊗ FDP24N40	⊣ FDP24N40	⇒ FDP26N40
↔ FDP2710_F085	⇒ FDP33N25	D FDP33N25	⊗ FDP3651U	⊣ FDP3651U
⊗ FDP39N20	D FDP39N20	⇒ FDP4020P	↔ FDP4020P	⇒ FDP42AN15
⊣ FDP42AN15A0	⊗ FDP42AN15A0	↔ FDP42AN15AO	⇒ FDP42NA15	⇒ FDP51N25
⊗ FDP51N25	⊣ FDP52N20	⊗ FDP52N20	D FDP5500_F085	⇒ FDP55N06
↔ FDP55N06	⊗ FDP55N0-07	⊣ FDP55N0F	⊗ FDP55N0NZ	⇒ FDP55N0NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited